1. 指出下列存储系统各具有多少个存储单元,至少需要几根地址线和数据线。 (1)64K×1 (2)256K×4

2. 试确定用 ROM 实现下列逻辑函数时所需的容量: 实现两个 3 位二进制数相乘的乘法器。

3. 一个有 4096 位的 DRAM,如果存储矩阵为 64×64 结构形式,且每个存储单元刷新时间为 100ns,则存储单元全部刷新一遍最快需要多长时间?如果刷新每行的最长间隔时间为15.6 μs,则该 DRAM 的刷新周期最长为多少?刷新操作所用时间占刷新周期的百分比是多少?

4. 试用一个具有片选使能 \overline{CE} 、输出使能 \overline{OE} 、读写控制 \overline{WE} 、容量为 $8K\times8$ 位的 SRAM 芯片和必要的逻辑门,设计一个 $16K\times16$ 位的存储器系统,试画出其逻辑图。